MgO/Rh/Fe_{100-x}Co_x膜の正方歪と一軸磁気異方性

吉田真司, 潟口嵩, 髙橋海里, 金谷峻介, 大宮裕之, 荒川明, 長谷川崇, 早坂浩二*, 斉藤伸*, 石尾俊二 (秋田大工資, *東北大学)

Tetragonally distorted structure and uniaxial magnetic anisotropy of MgO/Rh/Fe_{100-x}Co_x epitaxial film S. Yoshida, T. Kataguchi, K. Takahashi, S. Kanatani, H. Ohmiya, A. Arakawa, T. Hasegawa, K. Hayasaka*, S. Saito*, S. Ishio (Akita univ. *Tohoku univ.)

はじめに

高飽和磁化 $Fe_{1-x}Co_x$ 合金に正方歪を導入すると高結晶磁気異方性を発現することが、第一原理計算により示されている $^{1)}$ 。これによると、x=0.5-0.6、軸比(c/a)が 1.22-1.25 付近で一軸磁気異方性(K_u)が最大となり $K_u=1.0 \times 10^8$ erg/cm³ が予測される。実験では種々のバッファー層を用いたエピタキシャル成長によって FeCo に正方歪を導入が試みられている $^{2/3}$ 。しかし、依然として $Fe_{1-x}Co_x$ の結晶構造と K_u との相関は明らかではない。本研究では、Rh バッファー層を用いて正方晶 FeCo を合成し、 K_u と正方歪 c/a の相関を調べた。

実験方法

マグネトロンスパッタ法により、基板加熱温度 300 $^{\circ}$ で MgO(100)基板上に Rh を(001)配向させた。その後、基板加熱温度 200 $^{\circ}$ で FeCo を成膜し、次いで保護層として Ru を室温成膜した。磁気特性評価にはカー効果、磁気トルクメーター、VSM、構造解析には XRD、TEM 及び走査透過電子顕微鏡(STEM)を用いた。

実験結果

Fig.1 に MgO(100)sub./Rh(20.0nm)/Fe_{0.5}Co_{0.5}(3.0nm)/Ru (2.0nm)の HAAD-STEM 像(a) と SAD パターン(b)を示した。 FeCo と Rh の界面は平滑であり、エピタキシャル成長していることが確認できる。(b)では、Rh の強い回折スポットに加え、FeCo の弱い回折スポットが観察され、正方歪をもった FeCo が形成されていることが解る。この時の c/a は 1.11 で、格子関係は FeCo(001)[110]//Rh(001)[100]//MgO (001)[100]となる

一軸磁気異方性(K_{u1})の大きさは膜厚に依存しており、膜厚が 1.5-2.5nm で、 $1.6 \times 10^7 \mathrm{erg/cm^3}$ の最大値を示した。一方、上述のように、膜中は正方歪も誘起されており、正方歪も膜厚に依存している。そこで Fig.2 には Fe $_{50}\mathrm{Co}_{50}$ の種々の膜厚での K_{u1} と c/a データを用いて、 K_{u1} と c/a の関係をプロットした(図中 \bullet)。図のように、 K_{u1} は c/a に依存しており、c/a=1.15-1.35 で最大値となった。この結果は、Kotaらの第 1 原理計算の結果(図中 \circ)とよく一致しており、正方晶 FeCoの一軸磁気異方性(K_{u1})は、正方歪に起因していることと結論できる。また、膜厚 10.0nm 以上(c/a=1.0-1.04)付近でも、 $K_{u1}=0.5 \times 10^7 \mathrm{erg/cm^3}$ の値が観察されるが、これは FeCoの B2 規則化ドメインの[001]配向に起因していると思われる。

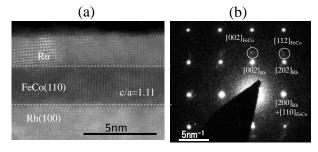


Fig. 1 (a) HAAD-STEM and (b) SAD images for the Rh/FeCo layer in the Rh/FeCo(3 nm)/Ru film.

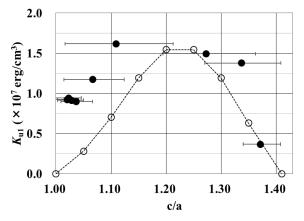


Fig. 2 K_{u1} as a function of c/a for Rh/Fe₅₀Co₅₀ films. The predicted magnetocrystalline anisotropy for Rh/FeCo with S = 0 is also shown (open circles).

参考文献

- 1) Y. Kota and A. Sakuma, Appl. Phys. Express, 5, 113002 (2012)
- 2) B. Wang et al , J. Appl. Phys., 115, 133908 (2014)
- 3) L. Reichel et al, J. Appl. Phys., 116, 213901 (2014)